

Preliminary datasheet

EasyBRIDGE 模块 采用斩波拓扑

特性

- 电气特性
 - $V_{CES} = 1200\text{ V}$
 - $I_{C\text{ nom}} = 50\text{ A} / I_{CRM} = 100\text{ A}$
 - 沟槽栅 IGBT7
- 机械特性
 - 低热阻的三氧化二铝 Al_2O_3 衬底
 - 紧凑型设计
 - 焊接技术
 - 集成的安装夹使安装坚固



Typical appearance

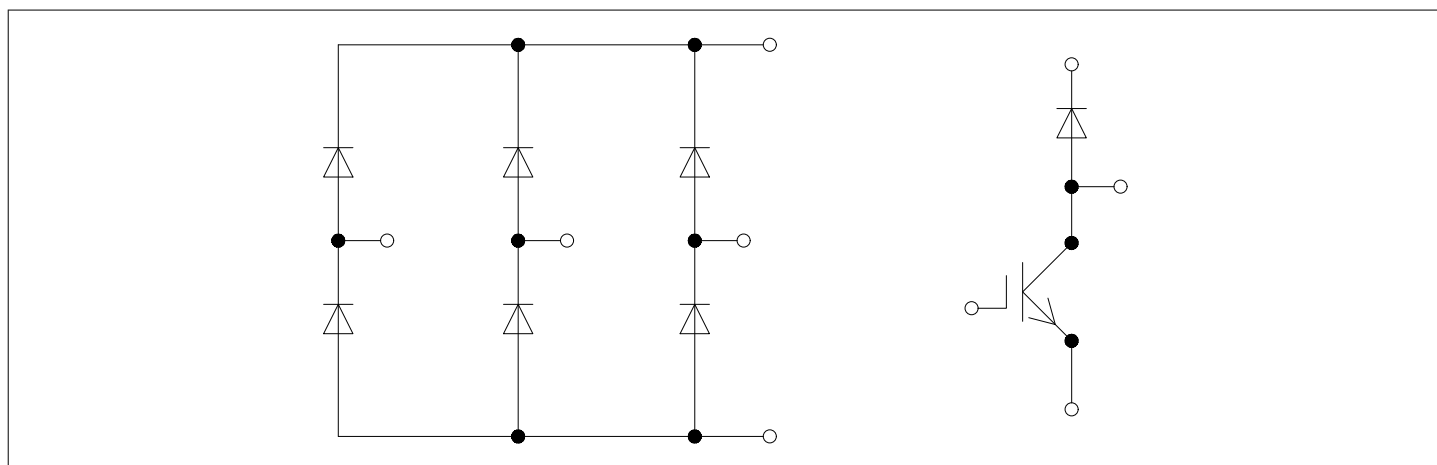
可选应用

- 辅助逆变器
- 空调
- 电机传动
- 伺服驱动器

产品认证

- 根据 IEC 60747、60749 和 60068 标准的相关测试，符合工业应用的要求。

描述



内容

	描述.....	1
	特性.....	1
	可选应用.....	1
	产品认证.....	1
	内容.....	2
1	封装.....	3
2	IGBT , 斩波器.....	3
3	Diode -斩波器.....	5
4	二极管,整流器.....	6
5	特征参数图表.....	7
6	电路拓扑图.....	10
7	封装尺寸.....	11
	修订历史.....	12
	免责声明.....	13

1 封装

1 封装

表 1 绝缘参数

特征参数	代号	标注或测试条件	数值	单位
绝缘测试电压	V_{ISOL}	RMS, $f = 50 \text{ Hz}$, $t = 1 \text{ min}$	2.5	kV
内部绝缘		基本绝缘 (class 1, IEC 61140)	Al_2O_3	
爬电距离	d_{Creep}	端子至散热器	11.5	mm
爬电距离	d_{Creep}	端子至端子	6.3	mm
电气间隙	d_{Clear}	端子至散热器	10.0	mm
电气间隙	d_{Clear}	端子至端子	5.0	mm
相对电痕指数	CTI		> 200	
相对温度指数 (电)	RTI	住房	140	°C

表 2 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
杂散电感, 模块	L_{sCE}			30		nH
模块引线电阻, 端子-芯片	$R_{AA'+CC'}$	$T_H = 25^\circ\text{C}$, 每个开关		4		mΩ
模块引线电阻, 端子-芯片	$R_{CC'+EE'}$	$T_H = 25^\circ\text{C}$, 每个开关		6		mΩ
储存温度	T_{stg}		-40		125	°C
Mounting force per clamp	F		20		50	N
重量	G			24		g

注: The current under continuous operation is limited to 30A rms per connector pin.

2 IGBT, 斩波器

表 3 最大标定值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值	单位
集电极-发射极电压	V_{CES}		$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	1200	V
连续集电极直流电流	I_{CDC}	$T_{vj \max} = 175^\circ\text{C}$	$T_H = 85^\circ\text{C}$	50	A
集电极重复峰值电流	I_{CRM}	$t_P = 1 \text{ ms}$		100	A
栅极-发射极峰值电压	V_{GES}			±20	V

表 4 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值			单位
				最小值	典型值	最大值	
集电极-发射极饱和电压	$V_{CE\ sat}$	$I_C = 50\ A, V_{GE} = 15\ V$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		1.50	TBD	V
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		1.64		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$		1.72		
栅极阈值电压	V_{GEth}	$I_C = 1.28\ mA, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25\ ^\circ C$		5.15	5.80	6.45	V
栅极电荷	Q_G	$V_{GE} = \pm 15\ V, V_{CE} = 600\ V$			0.92		μC
内部栅极电阻	R_{Gint}	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$			0		Ω
输入电容	C_{ies}	$f = 100\ kHz, T_{vj} = 25\ ^\circ C, V_{CE} = 25\ V, V_{GE} = 0\ V$			11.1		nF
反向传输电容	C_{res}	$f = 100\ kHz, T_{vj} = 25\ ^\circ C, V_{CE} = 25\ V, V_{GE} = 0\ V$			0.039		nF
集电极-发射极截止电流	I_{CES}	$V_{CE} = 1200\ V, V_{GE} = 0\ V$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$			0.0062	mA
栅极-发射极漏电流	I_{GES}	$V_{CE} = 0\ V, V_{GE} = 20\ V, T_{vj} = 25\ ^\circ C$				100	nA
开通延迟时间(感性负载)	t_{don}	$I_C = 50\ A, V_{CE} = 600\ V, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Gon} = 5.1\ \Omega$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		0.042		μs
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		0.045		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$		0.046		
上升时间(感性负载)	t_r	$I_C = 50\ A, V_{CE} = 600\ V, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Gon} = 5.1\ \Omega$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		0.036		μs
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		0.040		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$		0.043		
关断延迟时间(感性负载)	t_{doff}	$I_C = 50\ A, V_{CE} = 600\ V, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Goff} = 5.1\ \Omega$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		0.270		μs
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		0.350		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$		0.370		
下降时间(感性负载)	t_f	$I_C = 50\ A, V_{CE} = 600\ V, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Goff} = 5.1\ \Omega$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		0.110		μs
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		0.200		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$		0.270		
开通损耗能量(每脉冲)	E_{on}	$I_C = 50\ A, V_{CE} = 600\ V, L_\sigma = 35\ nH, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Gon} = 5.1\ \Omega, di/dt = 850\ A/\mu s (T_{vj} = 175\ ^\circ C)$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		4.47		mJ
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		5.2		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$		5.67		
关断损耗能量(每脉冲)	E_{off}	$I_C = 50\ A, V_{CE} = 600\ V, L_\sigma = 35\ nH, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Goff} = 5.1\ \Omega, dv/dt = 2900\ V/\mu s (T_{vj} = 175\ ^\circ C)$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		3.36		mJ
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		5.25		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$		6.45		

3 Diode-斩波器

表 4 特征值 (continued)

特征参数	代号	标注或测试条件		数值			单位
				最小值	典型值	最大值	
短路数据	I_{SC}	$V_{GE} \leq 15\text{ V}, V_{CC} = 800\text{ V}, V_{CEmax}=V_{CES}-L_{sCE} \cdot di/dt$	$t_P \leq 8\text{ }\mu\text{s}, T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$		190		A
			$t_P \leq 7\text{ }\mu\text{s}, T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$		180		
结一散热器热阻	R_{thJH}	每个 IGBT			0.840		K/W
允许开关的温度范围	$T_{vj\text{ op}}$			-40		175	$^\circ\text{C}$

注: $T_{vj\text{ op}} > 150^\circ\text{C}$ is allowed for operation at overload conditions. For detailed specifications, please refer to AN 2018-14.

3 Diode-斩波器

表 5 最大标定值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值	单位
反向重复峰值电压	V_{RRM}		$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	1200	V
连续正向直流电流	I_F			25	A
正向重复峰值电流	I_{FRM}	$t_P = 1\text{ ms}$		50	A
I2t-值	I^2t	$V_R = 0\text{ V}, t_P = 10\text{ ms}$	$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	72.5	A^2s
			$T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$	63	

表 6 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值			单位
				最小值	典型值	最大值	
正向电压	V_F	$I_F = 25\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$		1.83		V
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$		1.70		
			$T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$		1.63		
反向恢复峰值电流	I_{RM}	$I_F = 25\text{ A}, V_R = 600\text{ V}, V_{GE} = -15\text{ V}, -di_F/dt = 960\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$		21.6		A
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$		25.3		
			$T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$		27.6		
恢复电荷	Q_r	$I_F = 25\text{ A}, V_R = 600\text{ V}, V_{GE} = -15\text{ V}, -di_F/dt = 960\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$		1.89		μC
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$		3.53		
			$T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$		4.62		

4 二极管,整流器

表 6 特征值 (continued)

特征参数	代号	标注或测试条件		数值			单位
				最小值	典型值	最大值	
反向恢复损耗 (每脉冲)	E_{rec}	$I_F = 25\text{ A}$, $V_R = 600\text{ V}$, $V_{GE} = -15\text{ V}$, $-di_F/dt = 960\text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$)	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$		0.62		mJ
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$		1.3		
			$T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$		1.74		
结-散热器热阻	R_{thJH}	每个二极管			1.85		K/W
允许开关的温度范围	$T_{vj\text{ op}}$			-40		175	$^\circ\text{C}$

注: $T_{vj\text{ op}} > 150\text{ }^\circ\text{C}$ is allowed for operation at overload conditions. For detailed specifications, please refer to AN 2018-14.

4 二极管,整流器

表 7 最大标定值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值	单位
反向重复峰值电压	V_{RRM}	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$		1600	V
最大正向均方根电流(每芯片)	I_{FRMSM}	$T_H = 100\text{ }^\circ\text{C}$		50	A
最大整流器输出均方根电流	I_{RMSM}	$T_H = 100\text{ }^\circ\text{C}$		85	A
正向浪涌电流	I_{FSM}	$t_p = 10\text{ ms}$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	500	A
			$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$	400	
I2t-值	I^2t	$t_p = 10\text{ ms}$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	1250	A^2s
			$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$	800	

表 8 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值			单位
				最小值	典型值	最大值	
正向电压	V_F	$I_F = 50\text{ A}$	$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$		0.96		V
反向电流	I_r	$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$, $V_R = 1600\text{ V}$			1		mA
结-散热器热阻	R_{thJH}	每个二极管			1.11		K/W
允许开关的温度范围	$T_{vj, op}$			-40		150	$^\circ\text{C}$

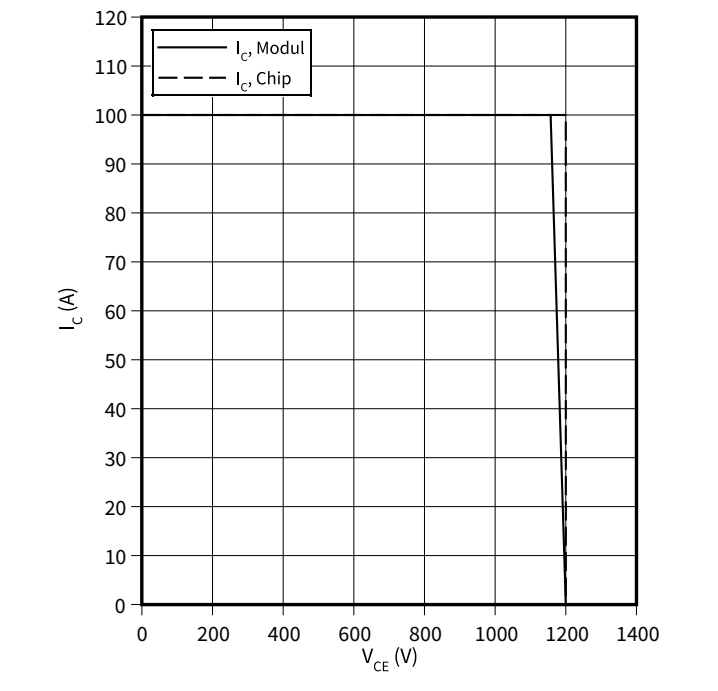
5 特征参数图表

5 特征参数图表

反偏安全工作区 (RBSOA), IGBT, 斩波器

$I_C = f(V_{CE})$

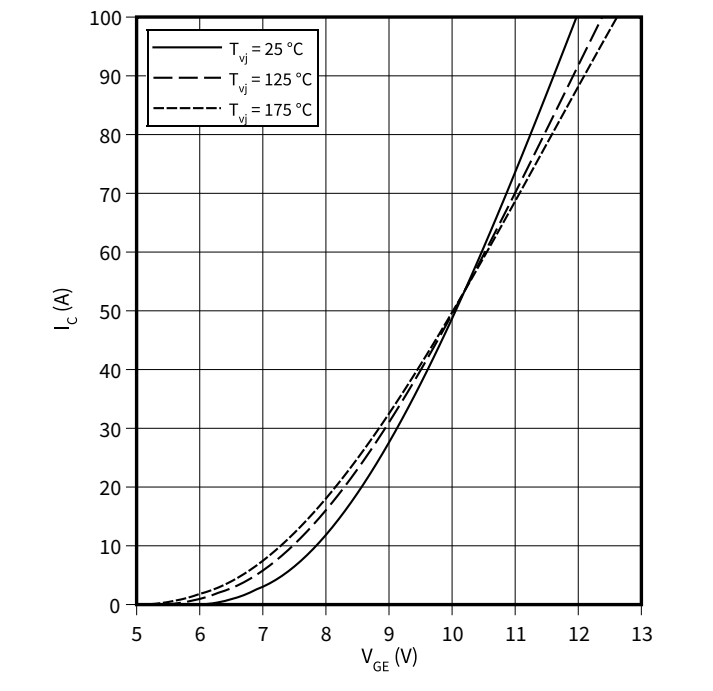
$R_{Goff} = 5.1 \Omega$, $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$



传输特性 (典型), IGBT, 斩波器

$I_C = f(V_{GE})$

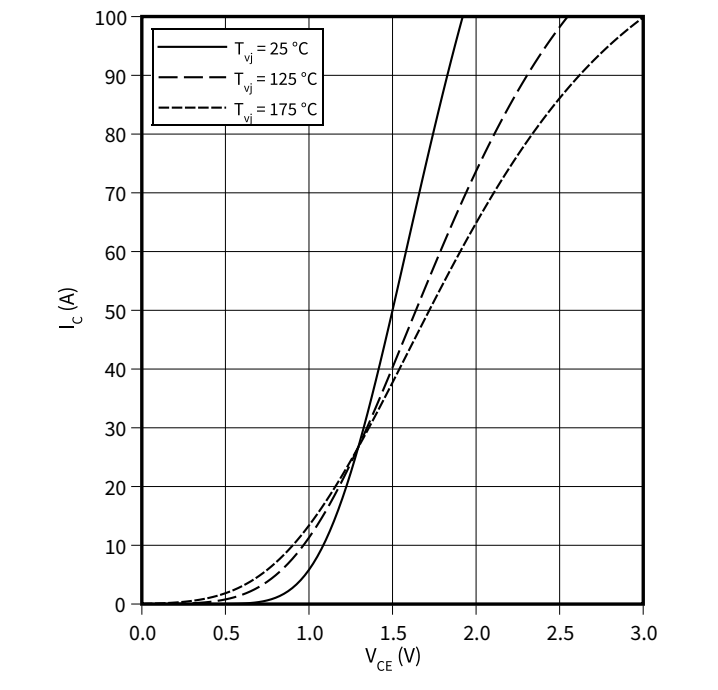
$V_{CE} = 20 \text{ V}$



输出特性 (典型), IGBT, 斩波器

$I_C = f(V_{CE})$

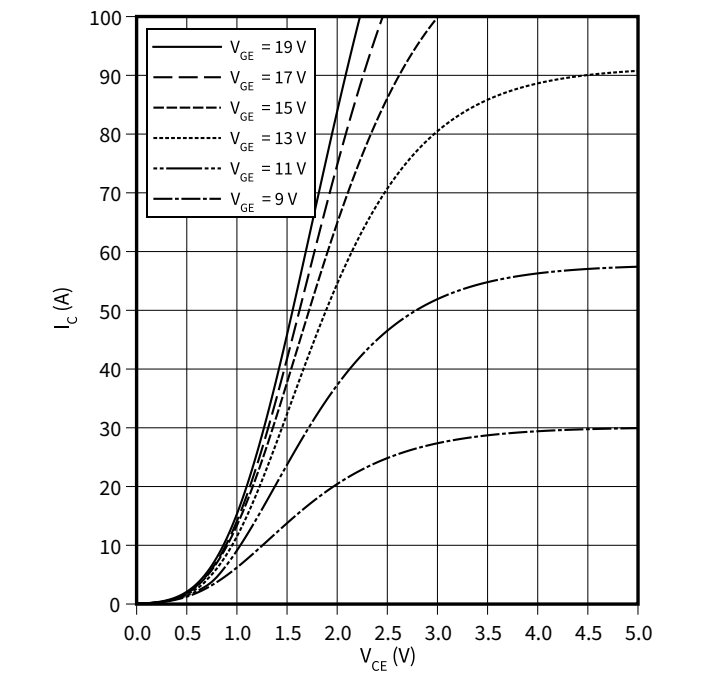
$V_{GE} = 15 \text{ V}$



输出特性 (典型), IGBT, 斩波器

$I_C = f(V_{CE})$

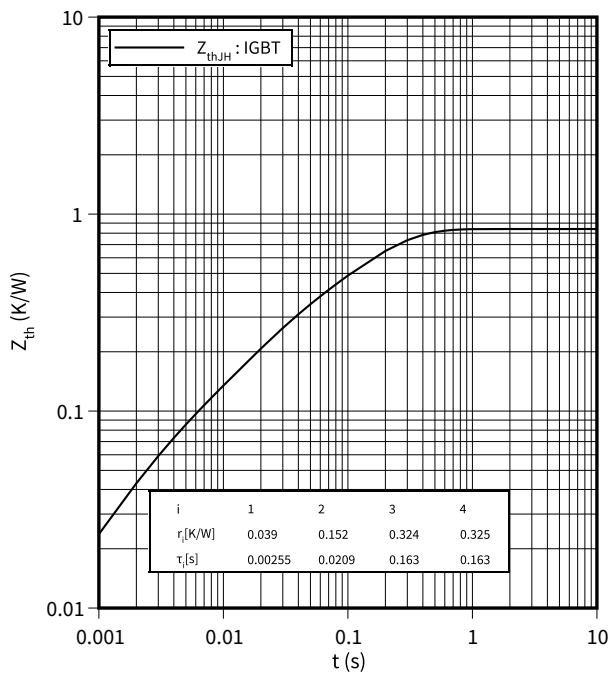
$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$



5 特征参数图表

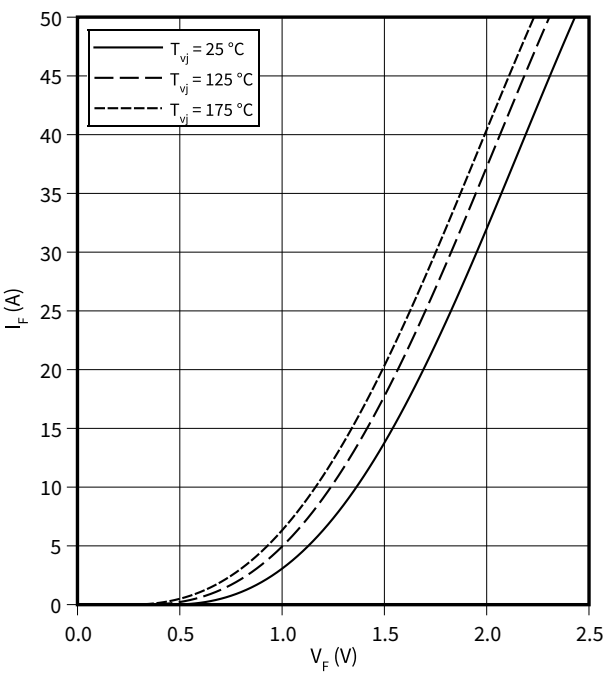
瞬态热阻抗 , IGBT, 斩波器

$Z_{th} = f(t)$



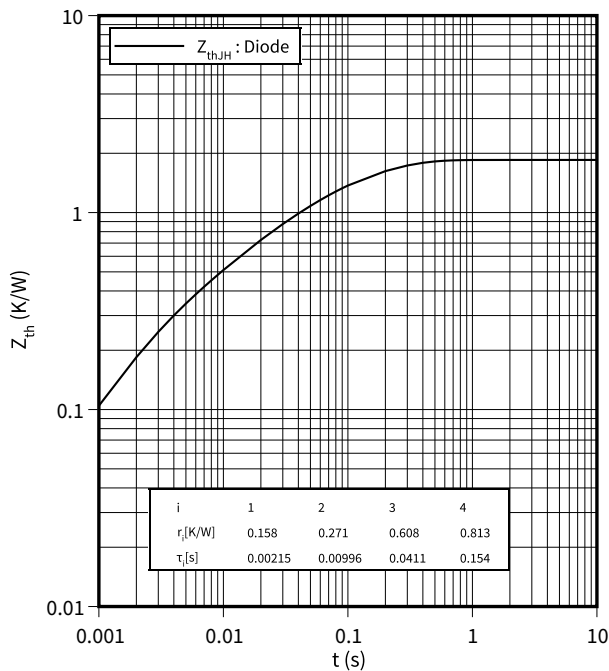
正向偏压特性 (典型), Diode-斩波器

$I_F = f(V_F)$



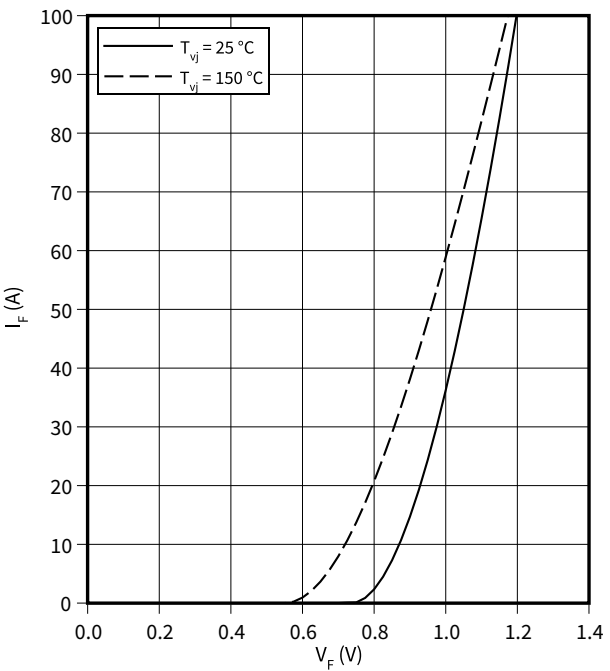
瞬态热阻抗 , Diode-斩波器

$Z_{th} = f(t)$



正向偏压特性 (典型), 二极管, 整流器

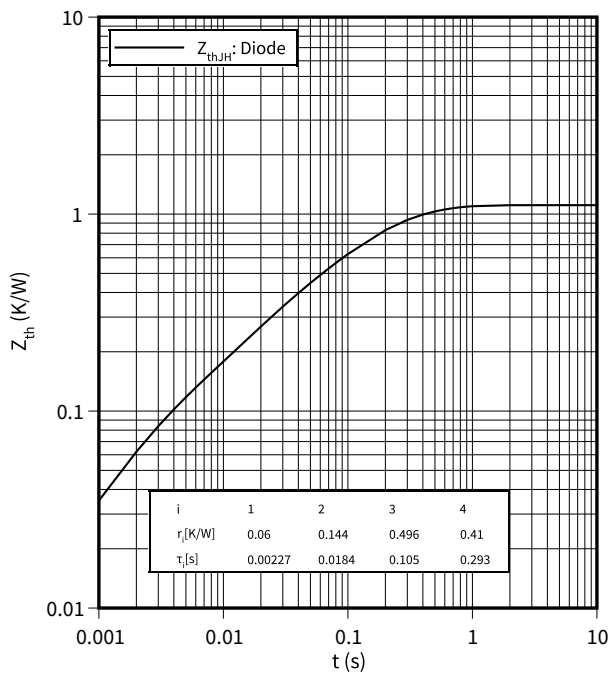
$I_F = f(V_F)$



5 特征参数图表

瞬态热阻抗, 二极管, 整流器

$Z_{th} = f(t)$



6 电路拓扑图

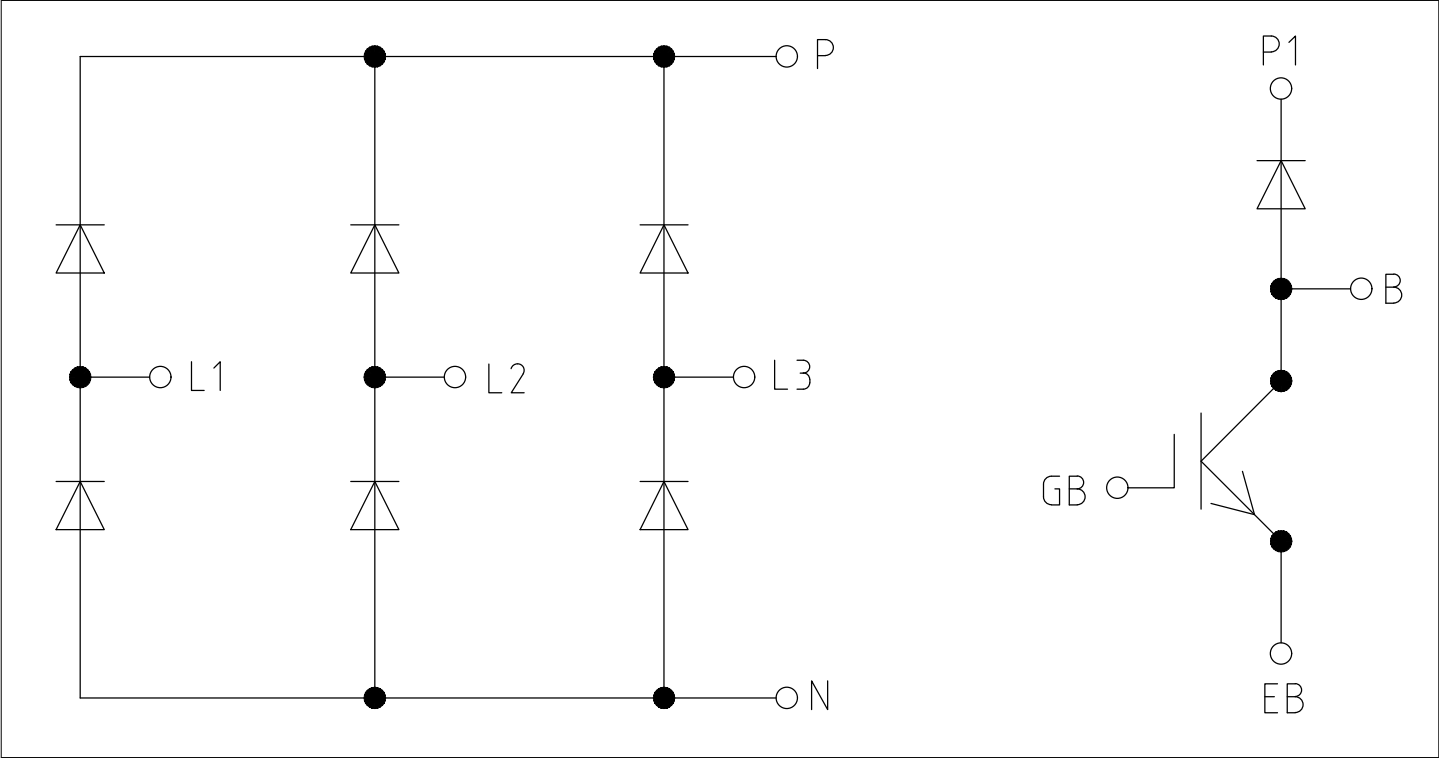


图 2

7 封装尺寸

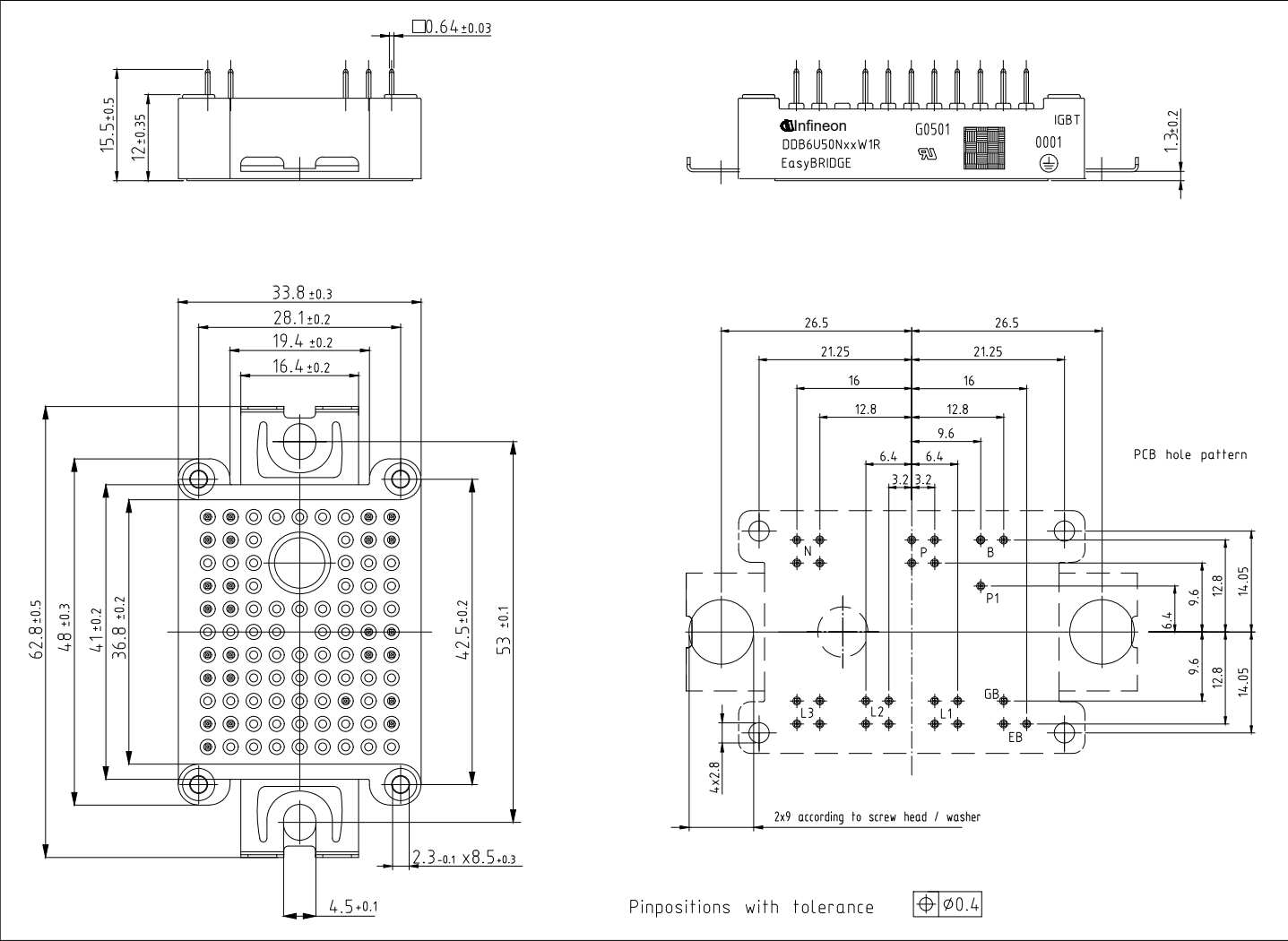


图 3



修订历史

修订历史

修订版本	发布日期	变更说明
0.10	2021-07-30	Initial version

商标

所有参照产品或服务名称和商标均为其各自所有者的财产。

版本 2021-07-30

出版方

Infineon Technologies AG
81726 Munich, Germany

© 2021 Infineon Technologies AG
保留所有权利。

您对本文档的内容有任何疑问吗？
电子邮件: erratum@infineon.com

文档编号
IFX-ABA699-001

重要提示

本文档所提供的任何信息绝不应被视为针对任何条件或者品质而做出的保证（质量保证）。

英飞凌对于本文档中所提及的任何事例、提示或者任何特定数值及/或任何关于产品应用方面的信息均在此明确声明其不承担任何保证或者责任，包括但不限于其不侵犯任何第三方知识产权的保证均在此排除。

此外，本文档所提供的任何信息均取决于客户履行本文档所载明的义务和客户遵守适用于客户产品以及与客户对于英飞凌产品的应用所相关的任何法律要求、规范和标准。

本文档所含的数据仅供经过专业技术培训的人员使用。客户自身的技术部门有义务对于产品是否适宜于其预期的应用和针对该等应用而言本文档中所提供的信息是否充分自行予以评估。

Please note that this product is not qualified according to the AEC Q100 or AEC Q101 documents of the Automotive Electronics Council.

警告事项

由于技术所需产品可能含有危险物质。如需了解该等物质的类型，请向离您最近的英飞凌科技办公室接洽。

除非由经英飞凌科技授权代表签署的书面文件中做出另行明确批准的情况外，英飞凌科技的产品不应 当被用于任何一项一旦产品失效或者产品使用的后 当被用于任何一项一旦产品失效或者产品使用的后 领域。